

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-149971

(P2013-149971A)

(43) 公開日 平成25年8月1日(2013.8.1)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H 0 1 L 51/50 (2006.01)	H 0 5 B 33/14 A	3 K 1 0 7
H 0 5 B 33/12 (2006.01)	H 0 5 B 33/12 B	

審査請求 未請求 請求項の数 25 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号	特願2013-595 (P2013-595)	(71) 出願人	512187343
(22) 出願日	平成25年1月7日 (2013.1.7)		三星ディスプレイ株式会社
(31) 優先権主張番号	10-2012-0006809		S a m s u n g D i s p l a y C o . , L t d .
(32) 優先日	平成24年1月20日 (2012.1.20)		大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路95
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		95, S a m s u n g 2 R o , G i h e u n g - G u , Y o n g i n - C i t y , G y e o n g g i - D o , K o r e a
		(74) 代理人	110000671
			八田国際特許業務法人
		(72) 発明者	鄭 鎮 九
			大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路95
			三星ディスプレイ株式会社内
		最終頁に続く	

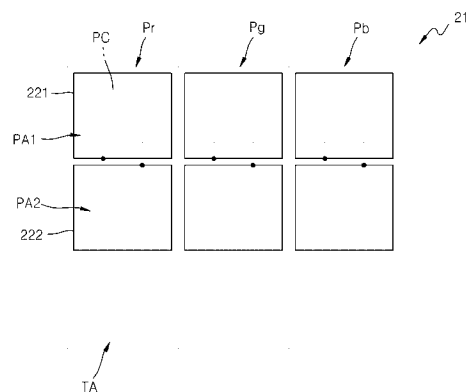
(54) 【発明の名称】 有機発光表示装置

(57) 【要約】

【課題】透過率が向上されて透明であると共に両面発光の可能な有機発光表示装置を提供する。

【解決手段】第1有機発光素子を含む第1発光領域 P A 1 と、第1発光領域 P A 1 と重畳せずに第1発光領域 P A 1 に隣接して位置し、第2有機発光素子を含む第2発光領域 P A 2 と、第1有機発光素子 P A 1 及び第2有機発光素子 P A 2 と電氣的に連結されたピクセル回路部 P C と、第1発光領域 P A 1 及び第2発光領域 P A 2 と重畳せずに第1発光領域 P A 1 及び第2発光領域 P A 2 に隣接して位置し、外光が透過するように構成された透過領域 T A と、を備える有機発光表示装置。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第 1 有機発光素子を含む第 1 発光領域と、

前記第 1 発光領域と重畳せずに前記第 1 発光領域に隣接して位置し、第 2 有機発光素子を含む第 2 発光領域と、

前記第 1 有機発光素子及び前記第 2 有機発光素子と電氣的に連結されたピクセル回路部と、

前記第 1 発光領域及び前記第 2 発光領域と重畳せずに前記第 1 発光領域及び前記第 2 発光領域に隣接して位置し、外光が透過するように構成された透過領域と、を備える有機発光表示装置。

10

【請求項 2】

前記ピクセル回路部は、前記第 1 発光領域と重畳して配置され、前記第 2 発光領域と重畳しないように配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 3】

前記第 1 有機発光素子は、光を反射するように構成された第 1 ピクセル電極を含むことを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 4】

前記第 2 有機発光素子は、光を透過するように構成された第 2 ピクセル電極を含むことを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 5】

20

前記ピクセル回路部は、前記第 1 有機発光素子と前記第 2 有機発光素子とを独立して駆動することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 6】

前記ピクセル回路部は、前記第 1 有機発光素子に電氣的に連結された第 1 発光 T F T と、前記第 2 有機発光素子に電氣的に連結された第 2 発光 T F T と、を備えることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 7】

前記ピクセル回路部にデータ信号、スキャン信号、及び電源をそれぞれ供給するデータライン、スキャンライン、及び電源ラインをさらに備え、

前記ピクセル回路部は、第 1 T F T、第 2 T F T、及びキャパシタを備え、

30

前記第 1 T F T のゲート電極は前記スキャンラインに電氣的に連結され、前記第 1 T F T の第 1 電極は前記データラインに電氣的に連結され、前記第 1 T F T の第 2 電極は前記第 2 T F T のゲート電極及び前記キャパシタに電氣的に連結され、

前記第 2 T F T の第 1 電極は前記電源ライン及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第 2 T F T の第 2 電極は前記第 1 及び第 2 発光 T F T に電氣的に連結されることを特徴とする請求項 6 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 8】

前記第 1 発光 T F T の第 1 電極は前記第 2 T F T に電氣的に連結され、前記第 1 発光 T F T の第 2 電極は前記第 1 有機発光素子に電氣的に連結され、

前記第 2 発光 T F T の第 1 電極は前記第 2 T F T に電氣的に連結され、前記第 2 発光 T F T の第 2 電極は前記第 2 有機発光素子に電氣的に連結されたことを特徴とする請求項 7 に記載の有機発光表示装置。

40

【請求項 9】

前記第 1 有機発光素子と前記第 2 有機発光素子とは、同じ色相の光を発光することを特徴とする請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 10】

前記透過領域に位置する透視窓をさらに備えることを特徴とする請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 11】

基板と、

50

前記基板上に形成され、それぞれ発光する第 1 及び第 2 発光領域と、外光が透過する透過領域と、ピクセル回路部とをそれぞれ備える複数のピクセルと、

前記各ピクセルの第 1 発光領域に配置されて前記ピクセル回路部と電氣的に連結され、透明導電膜及び反射膜をそれぞれ含む複数の第 1 ピクセル電極と、

前記各ピクセルの第 2 発光領域に配置されて前記ピクセル回路部と電氣的に連結され、かつ前記第 1 ピクセル電極と分離され、透明導電膜または半透過導電膜をそれぞれ含む複数の第 2 ピクセル電極と、

前記第 1 ピクセル電極と対向する第 1 対向電極と、

前記第 2 ピクセル電極と対向する第 2 対向電極と、

前記第 1 ピクセル電極と前記第 1 対向電極との間に配置され、第 1 発光層を含む第 1 有機膜と、 10

前記第 2 ピクセル電極と前記第 2 対向電極との間に配置され、第 2 発光層を含む第 2 有機膜と、を備える有機発光表示装置。

【請求項 1 2】

前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とは電氣的に連結されていることを特徴とする請求項 1 1 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 3】

前記第 1 対向電極は、光を透過するように形成されていることを特徴とする請求項 1 1 または 1 2 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 4】

前記第 2 対向電極は、光を反射するように形成されていることを特徴とする請求項 1 1 ~ 1 3 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 5】

前記第 1 対向電極及び前記第 2 対向電極は、Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr、Li、Ca、Yb、及びこれらの合金からなる群から選択された少なくとも 1 つの金属を含むことを特徴とする請求項 1 1 ~ 1 4 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 6】

前記各ピクセル回路部は、前記第 1 ピクセル電極と重畳して配置され、前記第 2 ピクセル電極と重畳しないように配置されていることを特徴とする請求項 1 1 ~ 1 5 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。 30

【請求項 1 7】

前記各ピクセル回路部は、前記第 1 ピクセル電極に電氣的に連結された第 1 発光 TFT と、前記第 2 ピクセル電極に電氣的に連結された第 2 発光 TFT と、を備えることを特徴とする請求項 1 1 ~ 1 6 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 8】

前記ピクセル回路部にデータ信号、スキャン信号、及び電源をそれぞれ供給するデータライン、スキャンライン、及び電源ラインをさらに備え、

前記ピクセル回路部は、第 1 TFT、第 2 TFT、及びキャパシタを備え、

前記第 1 TFT のゲート電極は前記スキャンラインに電氣的に連結され、前記第 1 TFT の第 1 電極は前記データラインに電氣的に連結され、前記第 1 TFT の第 2 電極は前記第 2 TFT のゲート電極及び前記キャパシタに電氣的に連結され、 40

前記第 2 TFT の第 1 電極は前記電源ライン及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第 2 TFT の第 2 電極は前記第 1 及び第 2 発光 TFT に電氣的に連結されることを特徴とする請求項 1 7 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 9】

前記第 1 発光 TFT の第 1 電極は前記第 2 TFT に電氣的に連結され、前記第 1 発光 TFT の第 2 電極は前記第 1 ピクセル電極に電氣的に連結され、

前記第 2 発光 TFT の第 1 電極は前記第 2 TFT に電氣的に連結され、前記第 2 発光 TFT の第 2 電極は前記第 2 ピクセル電極に電氣的に連結されたことを特徴とする請求項 1 50

8 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 20】

前記各ピクセル回路部は、前記第 1 ピクセル電極に電氣的に連結された第 1 ピクセル回路部と、前記第 2 ピクセル電極に電氣的に連結され前記第 1 ピクセル回路部と独立して動作する第 2 ピクセル回路部と、を備えることを特徴とする請求項 11 ~ 16 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 21】

前記第 1 ピクセル回路部及び前記第 2 ピクセル回路部は、前記第 1 発光領域と重畳して配置され、前記第 2 発光領域と重畳しないように配置されていることを特徴とする請求項 20 に記載の有機発光表示装置。

10

【請求項 22】

前記複数のピクセルのうち互いに隣接している少なくとも 2 個のピクセルの前記透過領域は、一体的に形成されていることを特徴とする請求項 11 ~ 21 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 23】

前記各透過領域に位置する複数の透視窓をさらに備えることを特徴とする請求項 11 ~ 22 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 24】

前記複数のピクセルのうち互いに隣接している少なくとも 2 個のピクセルの前記透視窓は、一体的に形成されていることを特徴とする請求項 23 に記載の有機発光表示装置。

20

【請求項 25】

前記第 2 対向電極は、光を反射する金属膜を含み、

前記金属膜は、前記第 1 発光領域及び前記透視窓に対応する開口を含むことを特徴とする請求項 23 または 24 に記載の有機発光表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光表示装置に係り、さらに詳細には、透明な有機発光表示装置に関する。

【背景技術】

30

【0002】

有機発光表示装置は、視野角、コントラスト、応答速度、消費電力などの特性に優れるため、MP3 プレーヤーや携帯電話などの個人用携帯器機からテレビ (TV) に至るまで応用範囲が広がりつつある。

【0003】

かかる有機発光表示装置は自発光特性を持ち、液晶表示装置 (Liquid Crystal Display、以下、「LCD」と称する) とは異なって別途の光源を必要としないので、厚さ及び重量を低減させることができる。

【0004】

また、有機発光表示装置は、装置内部の薄膜トランジスタ (Thin Film Transistor、以下、「TFT」と称する) や有機発光素子を透明な形態にすることで、透明表示装置として形成することができる。

40

【0005】

ところが、かかる透明表示装置では、スイッチオフ状態である時、反対側に位置している物体またはイメージが、有機発光素子だけでなく、TFT 及び複数の配線などのパターン、ならびにこれらの間の空間を透過してユーザに伝達されるが、たとえ透明表示装置であるとしても、上述した有機発光素子、TFT、及び配線自体の透過率があまり高くなく、これらの間の空間も非常に小さいため、ディスプレイ全体の透過率は高くない。

【0006】

また、上述したパターン、すなわち、有機発光素子、TFT、及び配線のパターンによ

50

って、ユーザは歪曲されたイメージを伝達される。これは、前記パターン間の間隔が数百nmレベルであるため、可視光波長と同一レベルになって透過された光の散乱を引き起こすからである。

【0007】

一方、有機発光表示装置は、LCDに比べれば、両面発光装置としても具現できる。ところが、既存の両面発光装置の場合、両面で同じイメージが具現されるため、一面に具現される画像は他面に具現される画像に対して左右が逆になるという限界がある。

【0008】

これ以外に、独立した有機発光表示装置を2つ製作し、これを互いに当接させて両面ディスプレイを具現する場合もあるが、この場合には透明表示装置を具現できないという限界がある。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0009】

【特許文献1】韓国公開特許第10-2011-0097046号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

本発明は、透過領域での透過率が向上されて透明であると共に、両面発光の可能な有機発光表示装置を提供するところにその目的がある。

20

【0011】

本発明の他の目的は、透過光の散乱を抑制して透過イメージの歪曲現象が防止された透明な有機発光表示装置を提供するところにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

上記目的を達成するために、本発明は、第1有機発光素子を含む第1発光領域と、前記第1発光領域と重畳せずに前記第1発光領域に隣接して位置し、第2有機発光素子を含む第2発光領域と、前記第1有機発光素子及び前記第2有機発光素子と電気的に連結されたピクセル回路部と、前記第1発光領域及び前記第2発光領域と重畳せずに前記第1発光領域及び前記第2発光領域に隣接して位置し、外光が透過するように構成された透過領域と、を備える有機発光表示装置を提供する。

30

【0013】

本発明の他の特徴によれば、前記ピクセル回路部は、前記第1発光領域と重畳して配置され、前記第2発光領域と重畳しないように配置されている。

【0014】

本発明の他の特徴によれば、前記第1有機発光素子は、光を反射するように構成された第1ピクセル電極を含む。

【0015】

本発明の他の特徴によれば、前記第2有機発光素子は、光を透過するように構成された第2ピクセル電極を含む。

40

【0016】

本発明の他の特徴によれば、前記ピクセル回路部は、前記第1有機発光素子と前記第2有機発光素子とを独立して駆動する。

【0017】

本発明の他の特徴によれば、前記ピクセル回路部は、前記第1有機発光素子に電気的に連結された第1発光TFTと、前記第2有機発光素子に電気的に連結された第2発光TFTと、を備える。

【0018】

本発明の他の特徴によれば、前記ピクセル回路部にデータ信号、スキャン信号、及び電源をそれぞれ供給するデータライン、スキャンライン、及び電源ラインをさらに備え、前

50

記ピクセル回路部は、第 1 T F T、第 2 T F T、及びキャパシタを備え、前記第 1 T F T のゲート電極は前記スキャンラインに電氣的に連結され、前記第 1 T F T の第 1 電極は前記データラインに電氣的に連結され、前記第 1 T F T の第 2 電極は前記第 2 T F T のゲート電極及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第 2 T F T の第 1 電極は前記電源ライン及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第 2 T F T の第 2 電極は前記第 1 及び第 2 発光 T F T に電氣的に連結される。

【 0 0 1 9 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 1 発光 T F T の第 1 電極は前記第 2 T F T に電氣的に連結され、前記第 1 発光 T F T の第 2 電極は前記第 1 有機発光素子に電氣的に連結され、前記第 2 発光 T F T の第 1 電極は前記第 2 T F T に電氣的に連結され、前記第 2 発光 T F T の第 2 電極は前記第 2 有機発光素子に電氣的に連結される。

10

【 0 0 2 0 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 1 有機発光素子と前記第 2 有機発光素子とは、同じ色相の光を発光する。

【 0 0 2 1 】

本発明の他の特徴によれば、前記透過領域に位置する透視窓をさらに備える。

【 0 0 2 2 】

上記目的を達成するために、本発明はまた、基板と、前記基板上に形成され、それぞれ発光する第 1 及び第 2 発光領域と、外光を透過する透過領域と、ピクセル回路部とをそれぞれ備える複数のピクセルと、前記各ピクセルの第 1 発光領域に配置されて前記ピクセル回路部と電氣的に連結され、透明導電膜及び反射膜をそれぞれ含む複数の第 1 ピクセル電極と、前記各ピクセルの第 2 発光領域に配置されて前記ピクセル回路部と電氣的に連結され、かつ前記第 1 ピクセル電極と分離され、透明導電膜または半透過導電膜をそれぞれ含む複数の第 2 ピクセル電極と、前記第 1 ピクセル電極と対向する第 1 対向電極と、前記第 2 ピクセル電極と対向する第 2 対向電極と、前記第 1 ピクセル電極と前記第 1 対向電極との間に配置され、第 1 発光層を含む第 1 有機膜と、前記第 2 ピクセル電極と前記第 2 対向電極との間に配置され、第 2 発光層を含む第 2 有機膜と、を備える有機発光表示装置を提供する。

20

【 0 0 2 3 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 1 対向電極と前記第 2 対向電極とは電氣的に連結されている。

30

【 0 0 2 4 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 1 対向電極は、光を透過するように形成されている。

【 0 0 2 5 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 2 対向電極は、光を反射するように形成されている。

【 0 0 2 6 】

本発明の他の特徴によれば、前記第 1 対向電極及び前記第 2 対向電極は、A g、M g、A l、P t、P d、A u、N i、N d、I r、C r、L i、C a、Y b、及びこれらの合金からなる群から選択された少なくとも 1 つの金属を含む。

40

【 0 0 2 7 】

本発明の他の特徴によれば、前記各ピクセル回路部は、前記第 1 ピクセル電極と重畳して配置され、前記第 2 ピクセル電極と重畳しないように配置されている。

【 0 0 2 8 】

本発明の他の特徴によれば、前記各ピクセル回路部は、前記第 1 ピクセル電極に電氣的に連結された第 1 発光 T F T と、前記第 2 ピクセル電極に電氣的に連結された第 2 発光 T F T と、を備える。

【 0 0 2 9 】

本発明の他の特徴によれば、前記ピクセル回路部にデータ信号、スキャン信号、及び電

50

源をそれぞれ供給するデータライン、スキャンライン、及び電源ラインをさらに備え、前記ピクセル回路部は、第１ＴＦＴ、第２ＴＦＴ、及びキャパシタを備え、前記第１ＴＦＴのゲート電極は前記スキャンラインに電氣的に連結され、前記第１ＴＦＴの第１電極は前記データラインに電氣的に連結され、前記第１ＴＦＴの第２電極は前記第２ＴＦＴのゲート電極及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第２ＴＦＴの第１電極は前記電源ライン及び前記キャパシタに電氣的に連結され、前記第２ＴＦＴの第２電極は前記第１及び第２発光ＴＦＴに電氣的に連結される。

【００３０】

本発明の他の特徴によれば、前記第１発光ＴＦＴの第１電極は前記第２ＴＦＴに電氣的に連結され、前記第１発光ＴＦＴの第２電極は前記第１ピクセル電極に電氣的に連結され、前記第２発光ＴＦＴの第１電極は前記第２ＴＦＴに電氣的に連結され、前記第２発光ＴＦＴの第２電極は前記第２ピクセル電極に電氣的に連結される。

10

【００３１】

本発明の他の特徴によれば、前記各ピクセル回路部は、前記第１ピクセル電極に電氣的に連結された第１ピクセル回路部と、前記第２ピクセル電極に電氣的に連結され前記第１ピクセル回路部と独立して動作する第２ピクセル回路部と、を備える。

【００３２】

本発明の他の特徴によれば、前記第１ピクセル回路部及び前記第２ピクセル回路部は、前記第１発光領域と重畳して配置され、前記第２発光領域と重畳しないように配置されている。

20

【００３３】

本発明の他の特徴によれば、前記複数のピクセルのうち互いに隣接している少なくとも２個のピクセルの前記透過領域は、一体的に形成されている。

【００３４】

本発明の他の特徴によれば、前記各透過領域に位置する複数の透視窓をさらに備える。

【００３５】

本発明の他の特徴によれば、前記複数のピクセルのうち互いに隣接している少なくとも２個のピクセルの前記透視窓は、一体的に形成されている。

【００３６】

本発明の他の特徴によれば、前記第２対向電極は、光を反射する金属膜を含み、前記金属膜は、前記第１発光領域及び前記透視窓に対応する開口を含む。

30

【発明の効果】

【００３７】

本発明によれば、外光に対する透過率を高めて透明な有機発光表示装置を具現すると共に両面発光が可能になる。

【００３８】

また、透過光の散乱を抑制して透過イメージの歪曲現象が防止された透明な有機発光表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【００３９】

40

【図１】本発明の一実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。

【図２】本発明の他の実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。

【図３】図１または図２の有機発光部の一例を示す概略図である。

【図４】図３のピクセル回路部の一例を示す回路図である。

【図５】図１または図２の有機発光部の他の例を示す概略図である。

【図６】図１または図２の有機発光部のさらに他の例を示す概略図である。

【図７】図３の有機発光部を示す断面図である。

【図８Ａ】第１発光領域の第１有機発光素子の一例を示す概略断面図である。

【図８Ｂ】第２発光領域の第２有機発光素子の一例を示す概略断面図である。

【図８Ｃ】第２発光領域の第２有機発光素子の他の例を示す概略断面図である。

50

【図 8 D】第 2 発光領域の第 2 有機発光素子のさらに他の例を示す概略断面図である。

【図 8 E】第 2 発光領域の第 2 有機発光素子のさらに他の例を示す概略断面図である。

【図 9】本発明の有機発光部の他の例を示す断面図である。

【図 10】本発明の有機発光部のさらに他の例を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0040】

以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明する。

【0041】

図 1 は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。

【0042】

10

図 1 を参照すれば、本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置 2 は、基板 1 の第 1 面 11 に形成された有機発光部 21 と、この有機発光部 21 を密封する密封基板 23 と、を備える。

【0043】

密封基板 23 は、透明な部材により形成され、有機発光部 21 からの画像を具現させ、有機発光部 21 への外気及び水分の浸透を遮断する。

【0044】

基板 1 及び密封基板 23 は、そのエッジが密封材 24 によって結合され、基板 1 と密封基板 23 との間の空間 25 が密封される。後述するように、空間 25 には、除湿剤や充填材などが配置される。

20

【0045】

なお、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置 2' では、密封基板 23 の代りに、図 2 に示したように、薄膜の密封フィルム 26 を有機発光部 21 上に形成することで有機発光部 21 を外気から保護する。密封フィルム 26 は、酸化シリコンまたは窒化シリコンなどの無機物からなる膜と、エポキシ、ポリイミドなどの有機物からなる膜とが交互に成膜された構造を採用できるが、必ずしもこれに限定されるものではなく、透明な薄膜状の密封構造ならば、いかなるものでも適用できる。

【0046】

図 3 は、図 1 または図 2 の有機発光部 21 の一例を示す概略図であり、互いに隣接している赤色ピクセル P_r、緑色ピクセル P_g、及び青色ピクセル P_bを示す平面図である。

30

【0047】

各赤色ピクセル P_r、緑色ピクセル P_g、及び青色ピクセル P_bは、第 1 発光領域 P_{A1} と第 2 発光領域 P_{A2} と透過領域 T_A とを有する。

【0048】

各ピクセル P_r、P_g、P_bで、第 1 発光領域 P_{A1}、第 2 発光領域 P_{A2}、及び透過領域 T_A が図 3 の縦方向に互いに隣接して順次に配列できるが、その配列順序は多様に変り得るということはいうまでもない。例えば、透過領域 T_A が最上部または中間部に配列されてもよい。

【0049】

図 3 に示したように、各第 1 発光領域 P_{A1} 内には、ピクセル回路部 P_C が備えられている。たとえ図 3 には示されていないとしても、ピクセル回路部 P_C に連結される各種配線は、第 1 発光領域 P_{A1} を通るように配置されるか、または第 1 発光領域 P_{A1} に隣接して配置される。

40

【0050】

図 4 は、図 3 のピクセル回路部 P_C の一例を示す回路図である。

【0051】

図 4 を参照すれば、スキャンライン S、データライン D、及び駆動電源である V_{dd} ライン V がピクセル回路部 P_C に電氣的に連結される。図面に図示していないが、ピクセル回路部 P_C の構成によって、スキャンライン S、データライン D、及び V_{dd} ライン V 以外にもさらに多様な導電ラインが備えられ得る。

50

【 0 0 5 2 】

ピクセル回路部 P C は、スキャンライン S 及びデータライン D に連結された第 1 T F T T 1 と、第 1 T F T T 1 及び V d d ライン V に連結された第 2 T F T T 2 と、第 1 T F T T 1 及び第 2 T F T T 2 に連結されたキャパシタ C s t と、を備える。

【 0 0 5 3 】

第 1 T F T T 1 のゲート電極はスキャンライン S に連結されてスキャン信号を受け、第 1 電極はデータライン D に、第 2 電極はキャパシタ C s t 及び第 2 T F T T 2 のゲート電極に連結される。

【 0 0 5 4 】

第 2 T F T T 2 の第 1 電極は、V d d ライン V 及びキャパシタ C s t に連結され、第 2 電極は、第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 の第 1 電極にそれぞれ連結される。

【 0 0 5 5 】

この時、第 1 T F T T 1 は、スイッチングトランジスタになり、第 2 T F T T 2 は、駆動トランジスタになる。

【 0 0 5 6 】

第 1 発光 T F T T 3 の第 2 電極は第 1 有機発光素子 E 1 と電氣的に連結され、第 2 発光 T F T T 4 の第 2 電極は第 2 有機発光素子 E 2 と電氣的に連結されている。したがって、図 3 及び図 4 を参照すれば、第 1 発光 T F T T 3 の第 2 電極は第 1 ピクセル電極 2 2 1 と電氣的に連結され、第 2 発光 T F T T 4 の第 2 電極は第 2 ピクセル電極 2 2 2 と電氣的に連結されている。

【 0 0 5 7 】

第 1 発光 T F T T 3 と第 2 発光 T F T T 4 のゲート電極とは、それぞれ別途の発光信号ラインに電氣的に連結されている。

【 0 0 5 8 】

図 4 で、T F T (T 1 ~ T 4) はいずれも P 型に図示されているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、少なくとも 1 つが N 型に形成されてもよい。また、上記のような T F T 及びキャパシタの数は、必ずしも図示された実施形態に限定されるものではなく、ピクセル回路部 P C によって 2 以上の T F T 、 1 以上のキャパシタがさらに組み合わせられてもよい。

【 0 0 5 9 】

本発明の一実施形態において、上記のようなピクセル回路部 P C は、第 1 発光領域 P A 1 と重畳して配置され、第 2 発光領域 P A 2 とは重畳しないように配置される。

【 0 0 6 0 】

各第 1 発光領域 P A 1 は、後述するように各サブピクセルで前面発光が行われる領域になるが、このように前面発光が行われる領域内にピクセル回路部 P C が位置し、透過領域 T A には、透過率を阻害する最大の要素のうちの 1 つであるピクセル回路部 P C の導電パターンが位置しないため、透過領域 T A の透過率はさらに高くなる。

【 0 0 6 1 】

すなわち、ピクセル回路部 P C は、第 1 ピクセル電極 2 2 1 により遮蔽される（隠される）ように第 1 ピクセル電極 2 2 1 と重畳して配置され、各第 2 ピクセル電極 2 2 2 とは重畳しないように配置される。

【 0 0 6 2 】

そして、上述したスキャンライン S 、データライン D 、及び V d d ライン V を含む導電ラインのうち少なくとも 1 つがいずれも第 1 ピクセル電極 2 2 1 と交差するように配置される。もちろん、これらの導電ラインは、ピクセル回路部 P C に比べて透過率を阻害する割合が少ないため、設計条件によっては、いずれも第 1 ピクセル電極 2 2 1 に隣接して配置させる。第 1 ピクセル電極 2 2 1 は、後述するように光を反射することができる導電性金属からなる反射膜を含むので、ピクセル回路部 P C を遮蔽する役割を果たす。

【 0 0 6 3 】

各第 2 発光領域 P A 2 は、各サブピクセルで背面発光が行われる領域になるが、このよ

10

20

30

40

50

うに背面発光が行われる領域内にピクセル回路部 P C が位置しないため、ピクセル回路部 P C が遮蔽されることで背面発光の発光効率が阻害されるという問題を解消できる。

【 0 0 6 4 】

一方、上記のようなピクセル回路部 P C の構成によって、データライン D を通じて入力された画像イメージ情報は、第 1 発光 T F T T 3 が開かれた場合には第 1 有機発光素子 E 1 で具現され、第 2 発光 T F T T 4 が開かれた場合には第 2 有機発光素子 E 2 で具現されて、第 1 有機発光素子 E 1 と第 2 有機発光素子 E 2 とが相異なるイメージを具現できる。したがって、時分割駆動を通じて前面発光になる面と、背面発光になる面との画像が互いにミラー像に反転されて見えないように両面発光を具現してもよい。もちろん、同じデータ信号を供給した状態で第 1 発光 T F T T 3 と第 2 発光 T F T T 4 とに同じスイッチング信号を印加する場合には、前面及び背面で反転されたミラー像のイメージが見られる。このようにピクセル回路部 P C は、第 1 有機発光素子 E 1 と第 2 有機発光素子 E 2 とがピクセル回路部の基本的な構成を共有した状態で、多様な画面具現を可能にする。

10

【 0 0 6 5 】

上記のようなピクセル回路部 P C は、図 5 に示したように、第 1 ピクセル電極 2 2 1 に電氣的に連結された第 1 ピクセル回路部 P C 1、及び第 2 ピクセル電極 2 2 2 に電氣的に連結された第 2 ピクセル回路部 P C 2 で構成され、第 1 ピクセル回路部 P C 1 と第 2 ピクセル回路部 P C 2 とは、それぞれ互いに独立して動作するものであってもよい。この時、第 1 ピクセル回路部 P C 1 及び第 2 ピクセル回路部 P C 2 は、一般的なピクセル回路部の構成をそのまま採用できる。

20

【 0 0 6 6 】

一方、透過領域 T A は、図 3 及び図 5 に示したように、各赤色ピクセル P r、緑色ピクセル P g、及び青色ピクセル P b 別に分離して形成されるが、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく、図 6 に示したように、各赤色ピクセル P r、緑色ピクセル P g、及び青色ピクセル P b が単一の透過領域 T A を有するようにできる。この場合には、透過領域 T A の面積が広くなるため、外光透過率をさらに高めることができる。

【 0 0 6 7 】

図 7 は、有機発光部の 1 ピクセルの一例を示す断面図である。

【 0 0 6 8 】

図 7 に示したように、本発明の一実施形態によれば、基板 1 の第 1 面 1 1 上にバッファ膜 2 1 1 が形成され、このバッファ膜 2 1 1 上に第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 が形成される。図 7 には、第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 のみ図示されているが、上述したピクセル回路部がいずれも形成される。

30

【 0 0 6 9 】

まず、バッファ膜 2 1 1 上に、第 1 半導体活性層 2 1 2 a 及び第 2 半導体活性層 2 1 2 b が形成される。

【 0 0 7 0 】

バッファ膜 2 1 1 は、不純元素の浸透を防止して表面を平坦化する役割を果たすものであり、このような役割を果たし得る多様な物質で形成される。一例として、バッファ膜 2 1 1 は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、もしくは窒化チタンなどの無機物やポリイミド、ポリエステル、アクリルなどの有機物、またはこれらの積層体で形成される。バッファ膜 2 1 1 は、必須構成要素ではなく、必要に応じては備えられなくてもよい。

40

【 0 0 7 1 】

第 1 半導体活性層 2 1 2 a 及び第 2 半導体活性層 2 1 2 b は多結晶シリコンで形成されるが、必ずしもこれらに限定されるものではなく、酸化物半導体で形成されてもよい。例えば、G - I - Z - O 層 [(I n ₂ O ₃) a (G a ₂ O ₃) b (Z n O) c 層] (a、b、c は、それぞれ a > 0、b > 0、c > 0 の条件を満たす整数) であり得る。

【 0 0 7 2 】

第 1 半導体活性層 2 1 2 a 及び第 2 半導体活性層 2 1 2 b を覆うように、ゲート絶縁膜

50

2 1 3 がバッファ膜 2 1 1 上に形成され、ゲート絶縁膜 2 1 3 上に第 1 ゲート電極 2 1 4 a 及び第 2 ゲート電極 2 1 4 b が形成される。

【0073】

第 1 ゲート電極 2 1 4 a 及び第 2 ゲート電極 2 1 4 b を覆うように、ゲート絶縁膜 2 1 3 上に層間絶縁膜 2 1 5 が形成され、この層間絶縁膜 2 1 5 上に第 1 ソース電極 2 1 6 a と第 1 ドレイン電極 2 1 7 a、及び第 2 ソース電極 2 1 6 b と第 2 ドレイン電極 2 1 7 b が形成され、それぞれ第 1 半導体活性層 2 1 2 a 及び第 2 半導体活性層 2 1 2 b と、コンタクトホールを通じてコンタクトされる。

【0074】

図 7 によれば、スキャンライン S は、第 1 ゲート電極 2 1 4 a 及び第 2 ゲート電極 2 1 4 b の形成と同時に形成される。そして、データライン D 及び V d d ライン V は、第 1 ソース電極 2 1 6 a 及び第 2 ソース電極 2 1 6 b の形成と同時に形成される。

10

【0075】

上記のような第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 の構造は必ずしもこれに限定されるものではなく、多様な形態の T F T の構造が適用できるということはいうまでもない。

【0076】

このような第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 を覆うようにパッシベーション膜 2 1 8 が形成される。パッシベーション膜 2 1 8 は、単一または複数層の絶縁膜であり得る。このパッシベーション膜 2 1 8 は、無機物及び / または有機物で形成される。

20

【0077】

パッシベーション膜 2 1 8 上には、図 7 に示したように、第 1 発光 T F T T 3 及び第 2 発光 T F T T 4 を遮蔽するように第 1 ピクセル電極 2 2 1 が形成され、この第 1 ピクセル電極 2 2 1 は、パッシベーション膜 2 1 8 に形成されたピアホールによって第 1 発光 T F T T 3 の第 1 ドレイン電極 2 1 7 a に連結される。

【0078】

そして、パッシベーション膜 2 1 8 上には、第 1 ピクセル電極 2 2 1 に隣接して第 2 ピクセル電極 2 2 2 が形成される。第 1 ピクセル電極 2 2 1 と第 2 ピクセル電極 2 2 2 とは互いに分離された構造を採り、第 2 ピクセル電極 2 2 2 は、パッシベーション膜 2 1 8 に形成されたピアホールによって第 2 発光 T F T T 4 の第 2 ドレイン電極 2 1 7 b に連結される。

30

【0079】

パッシベーション膜 2 1 8 上には、第 1 ピクセル電極 2 2 1 及び第 2 ピクセル電極 2 2 2 のエッジを覆うように画素定義膜 2 1 9 が形成される。

【0080】

第 1 ピクセル電極 2 2 1 上には第 1 有機膜 2 2 3 が形成され、第 1 有機膜 2 2 3 を覆うように第 1 対向電極 2 2 4 が形成される。

【0081】

第 2 ピクセル電極 2 2 2 上には第 2 有機膜 2 2 3 ' が形成され、第 2 有機膜 2 2 3 ' を覆うように第 2 対向電極 2 2 5 が形成される。

40

【0082】

第 1 対向電極 2 2 4 及び第 2 対向電極 2 2 5 は、図 7 に示したように、互いに電氣的に連結される。

【0083】

第 1 有機膜 2 2 3 及び第 2 有機膜 2 2 3 ' には、同じ物質が使われる。第 1 有機膜 2 2 3 及び第 2 有機膜 2 2 3 ' には、低分子または高分子有機膜が使われる。低分子有機膜を使う場合、ホール注入層 (H I L : H o l e I n j e c t i o n L a y e r)、ホール輸送層 (H T L : H o l e T r a n s p o r t L a y e r)、発光層 (E M L : E m i s s i o n L a y e r)、電子輸送層 (E T L : E l e c t r o n T r a n s p o r t L a y e r)、電子注入層 (E I L : E l e c t r o n I n j e c t i o n

50

Layer)などが単一あるいは複合の構造で積層されて形成され、使用可能な有機材料も、銅フタロシアニン(CuPc)、N,N-ジ(ナフタレン-1-イル)-N,N'-ジフェニル-ベンジジン(NPB)、トリス-8-ヒドロキシキノリンアルミニウム(Alq₃)などを含めて多様に適用できる。これらの低分子有機膜は、真空蒸着法で形成される。この時、発光層は、赤色、緑色、青色の画素ごとに独立されるように形成され、ホール注入層、ホール輸送層、電子輸送層、及び電子注入層などは共通層であり、赤色、緑色、青色の画素に共通に適用される。

【0084】

第1ピクセル電極221及び第2ピクセル電極222はアノード電極の機能を有し、第1対向電極224及び第2対向電極225はカソード電極の機能を有するが、もちろん、これらの第1ピクセル電極221及び第2ピクセル電極222と、第1対向電極224及び第2対向電極225との極性は互いに逆になってもよい。

【0085】

第1ピクセル電極221は、ピクセルごとに第1発光領域PA1に対応するサイズに形成される。そして、第2ピクセル電極222は、ピクセルごとに第2発光領域PA2に対応するサイズに形成される。

【0086】

第1対向電極224及び第2対向電極225は、有機発光部全体のあらゆるピクセルに対して共通の電圧が印加される。

【0087】

パッシベーション膜218、ゲート絶縁膜213、層間絶縁膜215、及び画素定義膜219は、透明な絶縁膜で形成することが望ましいが、必ずしもこれに限定されるものではない。この時、基板1は、絶縁膜が有する全体的な透過率より小さいか、またはそれと同じ透過率を有する。

【0088】

図8Aは、上記の第1発光領域PA1の第1有機発光素子の一例をさらに具体的に示す概略断面図であり、図8Bは、第2発光領域PA2の第2有機発光素子の一例をさらに具体的に示す概略断面図である。

【0089】

本発明の一実施形態によれば、第1ピクセル電極221は反射膜を含む電極になり、第1対向電極224は半透過半反射電極になる。したがって、第1発光領域PA1は、第1対向電極224の方向に画像を具現する前面発光型になる。

【0090】

このように第1ピクセル電極221が反射型電極として備えられる場合、その下部に配されたピクセル回路部は第1ピクセル電極221によって遮蔽された状態になり、これによって図7をみれば、第1対向電極224の上部外側から、ユーザは、第1ピクセル電極221の下部の第1発光TF TT3及び第2発光TF TT4の各パターンを観察できなくなる。

【0091】

また、このように第1ピクセル電極221が反射電極として備えられることで、発光された光が観察者側にのみ放出されるので、観察者の反対側に失われる光量を低減させることができる。

【0092】

一方、第2ピクセル電極222は透明電極として備えられ、第2対向電極225は反射電極になる。したがって、第2発光領域PA2は、第2ピクセル電極222の方向に画像を具現する背面発光型になる。

【0093】

第1ピクセル電極221は、第1透明導電膜221a、反射膜221b、及び第2透明導電膜221cの積層体で形成される。第1透明導電膜221a及び第2透明導電膜221cは、仕事関数の高いITO、IZO、ZnO、またはIn₂O₃などからなる。反射

10

20

30

40

50

膜 2 2 1 b は、A g、M g、A l、P t、P d、A u、N i、N d、I r、C r、L i、C a、Y b、またはこれらの化合物などからなる。

【 0 0 9 4 】

かかる第 1 ピクセル電極 2 2 1 上に、第 1 機能層 2 2 3 a、第 1 発光層 2 2 3 b、及び第 2 機能層 2 2 3 c が積層された第 1 有機膜 2 2 3 が形成され、この第 1 有機膜 2 2 3 上に第 1 対向電極 2 2 4 が形成される。

【 0 0 9 5 】

第 1 機能層 2 2 3 a は、ホール注入層及びホール輸送層を含み、第 2 機能層 2 2 3 c は、電子注入層及び電子輸送層を含む。

【 0 0 9 6 】

第 1 対向電極 2 2 4 は、仕事関数の小さな金属、すなわち、A g、M g、A l、P t、P d、A u、N i、N d、I r、C r、L i、C a、Y b、またはこれらの合金などからなる。第 1 対向電極 2 2 4 は、高透過率のために薄膜で形成するのが望ましいが、その厚さは 1 0 0 ~ 3 0 0 に形成できる。

【 0 0 9 7 】

この時、反射膜 2 2 1 b の表面と第 1 対向電極 2 2 4 との間の距離は、第 1 発光層 2 2 3 b で発光する光の波長について、光学的共振をなすように調節される。したがって、この距離は赤色、緑色、及び青色画素別に異なる。この光学的共振を引き起こす距離を合わせるために、第 1 機能層 2 2 3 a 及び / または第 2 機能層 2 2 3 c には、画素の色相別に厚さを異ならせる補助層をさらに形成する。

【 0 0 9 8 】

かかる構成の第 1 発光領域 P A 1 は、第 1 対向電極 2 2 4 の方向に画像を具現する前面発光型になり、光学的共振を引き起こす距離を合わせることで光抽出効率を極大化する。

【 0 0 9 9 】

一方、第 2 ピクセル電極 2 2 2 は、上述したように反射膜のない透明導電物のみからなる。したがって、第 1 ピクセル電極 2 2 1 の第 1 透明導電膜 2 2 1 a 及び第 2 透明導電膜 2 2 1 c のうち少なくとも 1 つと同時に形成される。しかし、本発明は必ずしもこれに限定されるものではなく、図 8 C に示したように、第 2 ピクセル電極 2 2 2 ' は、第 1 透明導電膜 2 2 2 a、反射膜 2 2 2 b、及び第 2 透明導電膜 2 2 2 c の積層体で形成され得る。第 1 透明導電膜 2 2 2 a 及び第 2 透明導電膜 2 2 2 c は、仕事関数の高い I T O、I Z O、Z n O、または I n ₂ O ₃ などからなる。反射膜 2 2 2 b は、A g、M g、A l、P t、P d、A u、N i、N d、I r、C r、L i、C a、Y b、またはこれらの化合物からなるが、薄膜に形成して半透過特性を有するようにする。第 2 ピクセル電極 2 2 2 の第 1 透明導電膜 2 2 2 a、反射膜 2 2 2 b、及び第 2 透明導電膜 2 2 2 c は、上述した第 1 ピクセル電極 2 2 1 の第 1 透明導電膜 2 2 1 a、反射膜 2 2 1 b、及び第 2 透明導電膜 2 2 1 c とそれぞれ同時に形成される。

【 0 1 0 0 】

このような第 2 ピクセル電極 2 2 2 上に、第 3 機能層 2 2 3 a '、第 2 発光層 2 2 3 b '、及び第 4 機能層 2 2 3 c ' が積層された第 2 有機膜 2 2 3 ' が形成され、この有機膜 2 2 3 ' 上に第 2 対向電極 2 2 5 が形成される。第 3 機能層 2 2 3 a ' 及び第 4 機能層 2 2 3 c ' は、第 1 機能層 2 2 3 a 及び第 2 機能層 2 2 3 c から延設される。第 2 発光層 2 2 3 b ' も第 1 発光層 2 2 3 b と同じ色相である場合、第 1 発光層 2 2 3 b から延設される。

【 0 1 0 1 】

第 2 発光領域 P A 2 は、第 2 ピクセル電極 2 2 2 の方向に画像を具現する背面発光型になるので、第 2 対向電極 2 2 5 は、半透過膜 2 2 5 a 及び金属膜 2 2 5 b を含む。半透過膜 2 2 5 a は、第 1 対向電極 2 2 4 と同一物質からなり、第 1 対向電極 2 2 4 から延設されたものであり得る。金属膜 2 2 5 b は、半透過膜 2 2 5 a 上に積層して反射膜としての機能を有する。金属膜 2 2 5 b は、A g、M g、A l、P t、P d、A u、N i、N d、I r、C r、L i、C a、Y b、またはこれらの合金などからなるが、その厚さを半透過

10

20

30

40

50

膜 2 2 5 a に比べて厚くして、第 2 有機膜 2 2 3 ' から放出された光の反射率を高め、対向電極全体の電圧降下を低減させる。金属膜 2 2 5 b は、図 8 D に示したように、半透過膜 2 2 5 a の形成前に形成されてもよいが、この場合、第 2 対向電極 2 2 5 は、金属膜 2 2 5 b と半透過膜 2 2 5 a とが順次に積層された積層体になる。

【 0 1 0 2 】

これらの構造で、第 2 対向電極 2 2 5 の半透過膜 2 2 5 a は、第 1 対向電極 2 2 4 と一体に形成される。

【 0 1 0 3 】

第 2 対向電極 2 2 5 は必ずしもこれらに限定されるものではなく、図 8 E に示したように、必要に応じて金属膜 2 2 5 b のみで形成されてもよい。

10

【 0 1 0 4 】

これらの第 2 対向電極 2 2 5 の実施形態は、図 8 C に示した第 2 ピクセル電極 2 2 2 ' の構造にも同じく適用できるということはいうまでもない。

【 0 1 0 5 】

図 7 では、第 2 対向電極 2 2 5 が、図 8 B に示したように、半透過膜 2 2 5 a と金属膜 2 2 5 b との積層体で形成されたことを示したが、必ずしもこれらに限定されるものではなく、図 8 D のように金属膜 2 2 5 b と半透過膜 2 2 5 a との積層体で形成されてもよく、図 8 E のように金属膜 2 2 5 b のみで形成されてもよい。

【 0 1 0 6 】

上記のような金属膜 2 2 5 b は、少なくとも透過領域 T A にまで延びないように形成されることが望ましい。

20

【 0 1 0 7 】

一方、本発明において、透過領域 T A における外光透過率をさらに高めるために、図 7 に示したように、透過領域 T A に透視窓 2 3 0 を形成できる。

【 0 1 0 8 】

透視窓 2 3 0 は、透過領域 T A に対応する領域に形成されるが、図 7 に示したように、透過領域 T A に対応する領域に、第 1 対向電極 2 2 4 及び第 2 対向電極 2 2 5 のいずれも形成されないように開口を形成して、第 1 透視窓 2 3 1 を具現できる。この第 1 透視窓 2 3 1 によって透過領域 T A における外光透過率が向上する。

【 0 1 0 9 】

しかし、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく、透過領域 T A に、図 9 に示したように、延長対向電極 2 2 6 を形成させてもよい。この延長対向電極 2 2 6 は、第 1 対向電極 2 2 4 及び半透過膜 2 2 5 a と同一物質で形成でき、半透過膜 2 2 5 a から延設されたものであり得る。このように、透過領域 T A にも延長対向電極 2 2 6 を形成させることで、第 1 対向電極 2 2 4 及び半透過膜 2 2 5 a から延設される半透過膜のパターニング工程を経なくてもよく、これによって製作がさらに容易になる。

30

【 0 1 1 0 】

第 2 対向電極 2 2 5 が、図 8 B、図 8 D、及び図 8 E のように金属膜 2 2 5 b を含む場合、金属膜 2 2 5 b は、図 7 及び図 9 に示したように、第 1 発光領域 P A 1 及び透過領域 T A にそれぞれ対応する開口を有するように形成される。金属膜 2 2 5 b の透過領域 T A に対応する開口は、第 1 透視窓 2 3 1 に対応するように形成される。これによって、前面発光を行う第 1 発光領域 P A 1 における光抽出効率を高め、外光が透過される透過領域 T A における外光透過率を高める。

40

【 0 1 1 1 】

図 1 0 は、本発明のさらに他の実施形態を示すものであり、画素定義膜 2 1 9 に第 2 透視窓 2 3 2 がさらに形成された実施形態を示す。第 2 透視窓 2 3 2 は、図 7 に示した第 1 透視窓 2 3 1 と連結されて透視窓 2 3 0 を構成できる。図 1 0 で、画素定義膜 2 1 9 のみに第 2 透視窓 2 3 2 が形成された例を示したが、第 2 透視窓 2 3 2 は、透過領域 T A に位置している絶縁膜のうち少なくとも 1 つの絶縁膜に形成される。

【 0 1 1 2 】

50

このような第２透視窓２３２は、透過領域ＴＡにおける透過率を高めるだけでなく、複数層の透明な絶縁膜による光干渉現象及びこれによる色純度低下と色変化とを防止できる。

【０１１３】

なお、たとえ図面には図示していないとしても、透視窓２３０を第２透視窓２３２のみで構成し、延長対向電極２２６には開口である第１透視窓を形成しなくてもよい。

【０１１４】

上記のような透視窓２３０は、図３に示す透過領域ＴＡの形状に対応するように、各赤色ピクセルＰ_r、緑色ピクセルＰ_g、及び青色ピクセルＰ_b別に分離されるように形成される。また、図６に示したように、赤色ピクセルＰ_r、緑色ピクセルＰ_g、及び青色ピクセルＰ_bが単一の透過領域ＴＡを有する場合には、赤色ピクセルＰ_r、緑色ピクセルＰ_g、及び青色ピクセルＰ_bが単一の透視窓を有するように形成される。

10

【０１１５】

本発明は、添付した図面に図示された実施形態を参照して説明されたが、これは例示的なものに過ぎず、当業者ならば、これより多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるという点を理解できるであろう。したがって、本発明の真の保護範囲は、特許請求の範囲のみによって定められねばならない。

【産業上の利用可能性】

【０１１６】

本発明は、有機発光表示装置関連の技術分野に好適に用いられる。

20

【符号の説明】

【０１１７】

- １ 基板、
- ２，２' 有機発光表示装置、
- １１ 第１面、
- ２１ 有機発光部、
- ２３ 密封基板、
- ２４ 密封材、
- ２５ 空間、
- ２６ 密封フィルム、
- ２１１ バッファ膜、
- ２１２ a，２１２ b 第１及び第２半導体活性層、
- ２１３ ゲート絶縁膜、
- ２１４ a，２１４ b 第１及び第２ゲート電極、
- ２１５ 層間絶縁膜、
- ２１６ a，２１６ b 第１及び第２ソース電極、
- ２１７ a，２１７ b 第１及び第２ドレイン電極、
- ２１８ パッシベーション膜、
- ２１９ 画素定義膜、
- ２２１ 第１ピクセル電極、
- ２２２ 第２ピクセル電極、
- ２２３，２２３' 第１及び第２有機膜、
- ２２４ 第１対向電極、
- ２２５ 第２対向電極、
- ２３０ 透視窓、
- ２３１ 第１透視窓、
- ２３２ 第２透視窓、
- ＰＡ１ 第１発光領域、
- ＰＡ２ 第２発光領域、
- ＴＡ 透過領域、

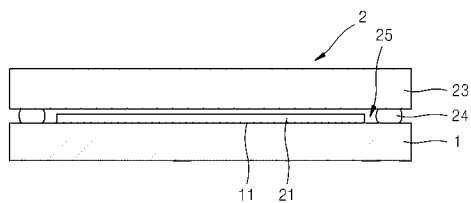
30

40

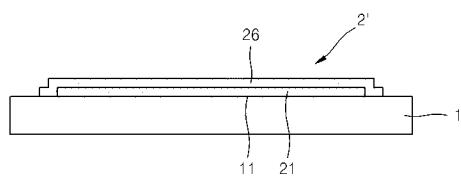
50

P C ピクセル回路部、
 S スキャンライン、
 C s t キャパシタ、
 D データライン、
 V V d dライン、
 T 1 , T 2 第 1 及び第 2 T F T、
 T 3 , T 4 第 1 及び第 2 発光 T F T。

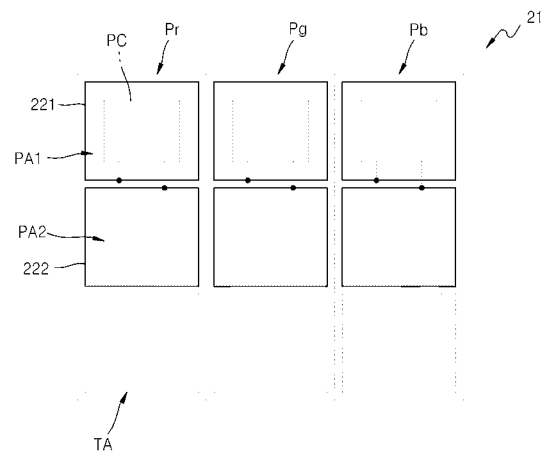
【 図 1 】



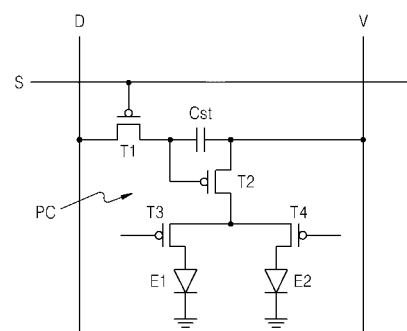
【 図 2 】



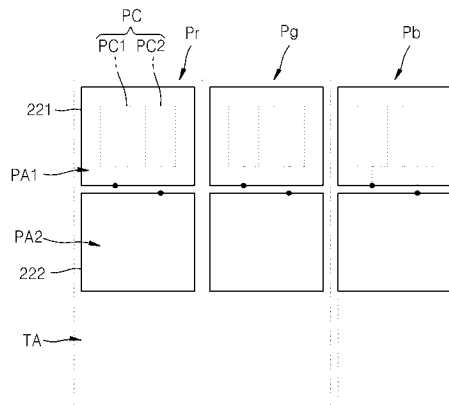
【 図 3 】



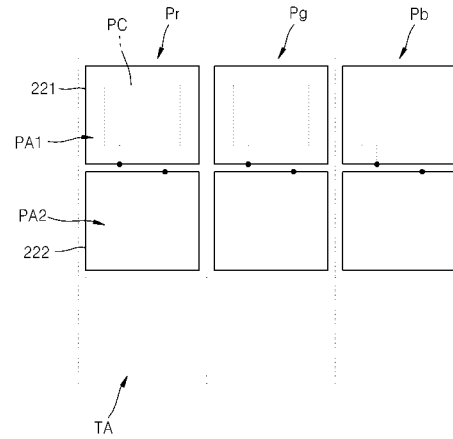
【 図 4 】



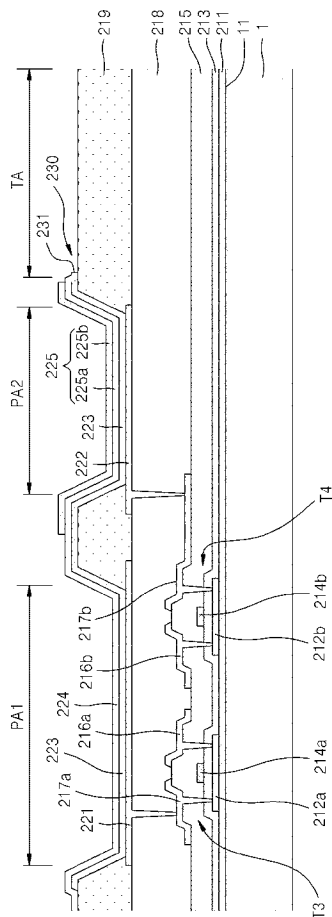
【図 5】



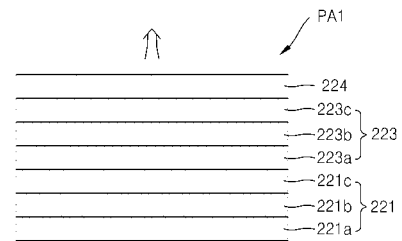
【図 6】



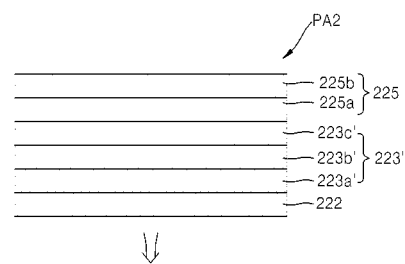
【図 7】



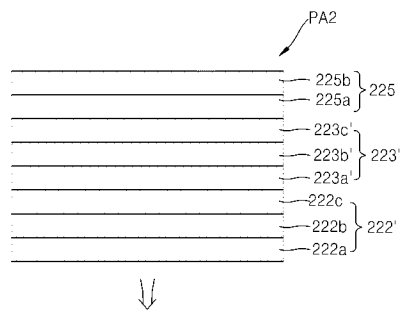
【図 8 A】



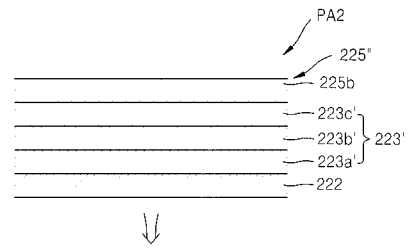
【図 8 B】



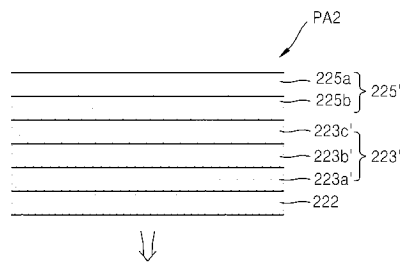
【図 8 C】



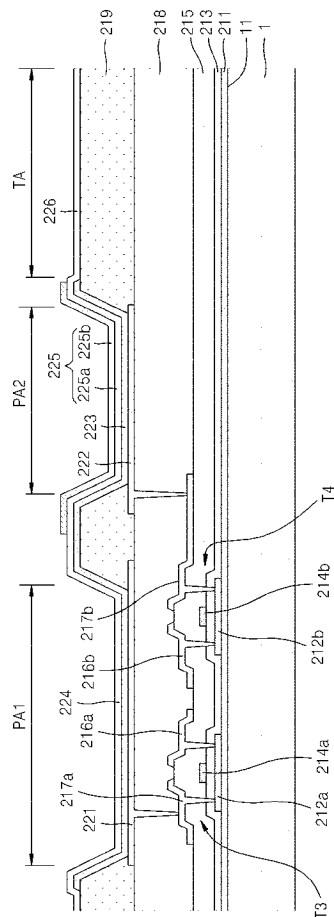
【図 8 E】



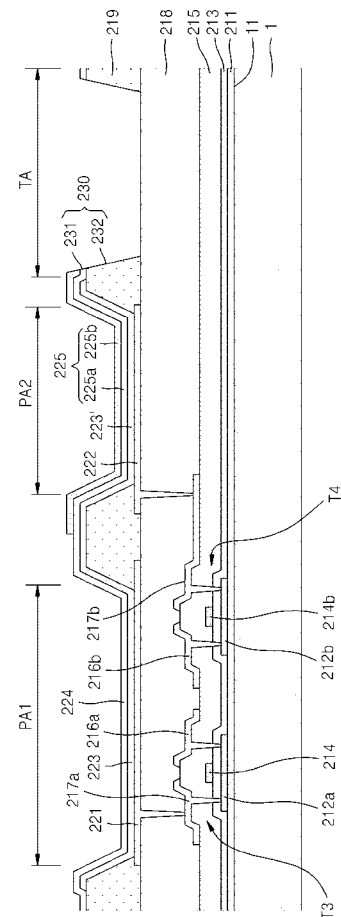
【図 8 D】



【図 9】



【図 10】



フロントページの続き

(72)発明者 崔 俊 呼

大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路 9 5 三星ディスプレイ株式會社内

(72)発明者 金 星 民

大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路 9 5 三星ディスプレイ株式會社内

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC41 DD04 DD22 DD27 DD44X DD44Y EE03 EE07
FF13 HH05

专利名称(译)	有机发光表示装置		
公开(公告)号	JP2013149971A	公开(公告)日	2013-08-01
申请号	JP2013000595	申请日	2013-01-07
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器的股票会社		
[标]发明人	鄭鎮九 崔俊呼 金星民		
发明人	鄭 鎮 九 崔 俊 呼 金 星 民		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/12		
CPC分类号	H01L27/326 H01L51/5218 H01L51/5234 H01L51/5265 H01L51/5296 H01L2251/5323 H01L23/53214 H01L23/53219 H01L23/53233 H01L31/0468 H01L2924/13069 H01L27/3248 H01L27/3276 H01L51/ /5215 H01L2251/301 H01L2251/558		
FI分类号	H05B33/14.A H05B33/12.B H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC41 3K107/DD04 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/DD44X 3K107/ /DD44Y 3K107/EE03 3K107/EE07 3K107/FF13 3K107/HH05		
优先权	1020120006809 2012-01-20 KR		
其他公开文献	JP2013149971A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

一种有机发光显示装置，包括：第一发光区域（PA1），包括第一有机发光二极管；第二发光区域（PA2），与第一发光区域相邻设置，不与第一发光区域重叠，第二发光区域包括第二有机发光二极管；像素电路单元，电连接到第一有机发光二极管和第二有机发光二极管；透射区域（TA）与第一和第二发射区域相邻并且不与第一和第二发射区域重叠，透射区域被配置为透射外部光。

